

佛山市国星光电股份有限公司

关于投资美国 RaySent 科技公司的进展性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资基本情况

2016 年 10 月 24 日，佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于投资美国 RaySent 科技公司进行 LED 大功率芯片研发的议案》。详细内容查看公司于 2016 年 10 月 25 日在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的第 2016-051 号《公司第四届董事会第二次会议决议公告》。根据《公司章程》相关规定，本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。公司董事会授权专人办理相关后续事宜，并签署与本次投资有关的一切协议和法律文件。

二、对外投资进展情况

（一）协议签署及工商信息

1、2016 年 12 月 13 日，公司与美国 RaySent 科技公司（RaySent Technologies, Inc.）（以下称“RaySent 科技”）签署增资协议，公司以自有资金 1,100 万美元增资 RaySent 科技，投资完成后，RaySent 科技成为公司的控股子公司。

2、本次投资事项已取得广东省商务厅核准并予以颁发《企业境外投资证书》，其余境外投资的核准及报备文件，由公司董事会授权专人负责办理后续具体事宜。

3、基本信息：

企业名称： RaySent Technologies, Inc.

经营范围：研发、生产、销售 LED 外延、芯片、器件及 LED 照明产品，以及其他半导体类相关器件及产品，提供售后服务，技术支持，相关工程和服务。

（二）技术背景

2016 年，拥有硅衬底大功率 LED 芯片及相关专有技术的主要核心团队成员

在美国成立 RaySent 科技，其所具有的知识产权及专有技术涵盖了外延生长、芯片制造、封装等 LED 生产过程的全部环节。通过本次合作， RaySent 科技将独有的硅衬底 GaN 外延技术及垂直结构 LED 及其衍生结构的知识产权授权给公司及子公司，并通过公司及子公司实现产业化生产。上述技术合作顺利实施后，RaySent 科技将独立开拓市场，同时继续致力于开发其他基于硅衬底的第三代半导体相关技术与产品。

三、对外投资的目的及对公司的影响

1、本次投资的 RaySent 科技硅衬底大功率 LED 芯片及相关专有技术具有高技术性和商业价值。硅衬底拥有晶体尺寸大、成本低、易加工、热导率高和热稳定性好等优点，可大幅降低 LED 芯片的造价，有利于 LED 器件的小型化和高电流密度化发展。同时，可期待薄膜结构的硅基 GaN LED 芯片有更高的良率和更好的器件可靠性。

2、公司本次投资的 RaySent 科技核心团队成员均有着二十年以上丰富的工作经验和产业发展经验。RaySent 科技团队长期研究及优化的薄膜结构 LED 芯片适用范围广，且相关芯片产品普遍利润率较高，将有助于公司规避同质化竞争，打造具有核心竞争力的新产品投放市场，可实现公司短时间、低成本地提高现有产品性能和规模化生产之目标。

3、公司致力成为全面发展的 LED 企业，本次合作是公司加快国际化进程及推进全球化战略实施的重要一步，也是落实创新战略的重要部署，有助于公司提升上游技术实力，促进公司上中下游产业链均衡做大做强做优，形成优势竞争格局；另一方面，随着 RaySent 科技的发展，公司可展望实现较好投资盈利预期，增强业务扩张能力，提升公司的产业地位、综合实力及新领域开拓能力。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 22 日